

Сведения о ведущей организации
по диссертации **Зай Яр Лвин**
«Эмиссионные свойства углеродных волокон и катодлюминесцентный источник
света на их основе»
по специальности 01.04.04 – физическая электроника.

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)»
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	КФ МГТУ и.Н.Э.Баумана
Ведомственная принадлежность	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Место нахождения	г. Калуга
Почтовый индекс, адрес организации	248000, г.Калуга, ул.Баженова,д.2
Веб-сайт	
Телефон	8 (4842)79-77-91
Адрес электронной почты	a.a.stolyarov@bmstu.ru
Список публикаций сотрудников КФ МГТУ по теме диссертации соискателя в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет <i>(не менее 5 и не более 15 публикаций)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andreev V.V., Maslovsky V.M., Andreev D.V., Stolyarov A.A. Charge effects in dielectric films of MIS structures being under high-field injection of electrons at ionizing radiation // Proc. SPIE 11022, 2019. P.1102207(1-7). DOI: 10.1117/12.2521985. 2. Andreev D.V., Bondarenko G.G., Andreev V.V., Stolyarov A.A. Automatized setup for researching of MIS structures under high-field tunnel injection of electrons at stress and measurement conditions // IEEE Pros. 2018 Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies (MWENT). 2018. P.1-3. DOI: 10.1109/MWENT.2018.8337209. 3. Andreev D.V., Bondarenko G.G., Andreev V.V., Stolyarov A.A. Investigation of Injection- and Radiation-Thermal Processes in Thin Gate Dielectric Films of MIS Structures // Key Engineering Materials. 2018. Vol. 781. P.47-52. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.781.47. 4. Andreev V.V., Bondarenko G.G., Andreev D.V, Akhmelkin D.M. Sensors based on MIS structures for study of ionization radiations // IEEE Pros. 2018 Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies (MWENT). 2018. P.1-3. DOI: 10.1109/MWENT.2018.8337203.

- | | |
|--|--|
| | <p>5. Andreev D.V., Bondarenko G.G., Andreev V.V., Stolyarov A.A. Method of stress and measurement current levels for MIS structures researching and modifying under high-field injection of electrons // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017. Vol. 168. P. 012057(1-6). DOI: 10.1088/1757-899X/168/1/012057.</p> <p>6. Andreev D.V., Bondarenko G.G., Andreev V.V., Maslovsky V.M., Stolyarov A.A. Modification of MIS Devices by Irradiation and High-Field Electron Injection Treatments // Acta Phys. Pol. A. 2017. Vol. 132. P. 245–248. DOI: 10.12693/APhysPolA.132.245.</p> <p>7. Andreev D.V., Bondarenko G.G., Andreev V.V., Maslovsky V.M., Stolyarov A.A. Modification of MIS structures with thermal SiO₂ films by phosphorus diffusion // High Temperature Material Processes: An International Quarterly of High-Technology Plasma Processes. 2017. Vol. 21. Issue 4. P.299-307. DOI: 10.1615/HighTempMatProc.2018025450</p> |
|--|--|